

Medidas de prestaciones de la memoria

Se utilizan cuatro parámetros, a menudo separados por guiones:

1. **CL (CAS Latency):** Tiempo, expresado en número de ciclos de reloj, que transcurre entre que el controlador de memoria envía una petición de lectura de una posición de memoria y el momento que los datos son enviados a los pines de salida del módulo. Este es el tiempo que se tarda en leer el primer bit de memoria de una DRAM, una vez que está seleccionada la fila correcta.
2. **TRCD(Row Address to column address delay):** Tiempo, en ciclos de reloj, que tarda en habilitarse la columna donde se encuentra la celda de memoria, después de habilitada la fila. El tiempo que se tarda en leer el primer bit de memoria sin estar la fila correcta seleccionada es $TRCD+CL$
3. **TRP (Row precharge):** Tiempo, en ciclos de reloj, que tarda la memoria en terminar el acceso a una fila de memoria y elegir otra fila de memoria para lectura. El tiempo que se tarda el primer bit de memoria de una DRAM cuando se ha seleccionado la fila equivocada es $TRP+TRCD+CL$
4. **TRAS (Row active time):** Tiempo mínimo, en ciclos de reloj, entre un estado activo de memoria y el momento en que el controlador de memoria la cierra. Debe ser mayor que $tRCD+tCAS$, porque de lo contrario se "cierra" la posición de memoria antes de tiempo, y debe hacerse otro acceso a memoria para completar la lectura.

Cuanto más pequeños sean los números, más rápida es la memoria.